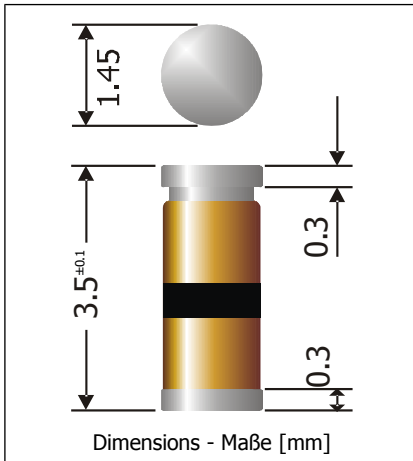


BR100-03LLD ... BR100-04LLD

Surface Mount Bidirectional Si-Trigger-Diodes (DIAC) Bidirektionale Si-Triggerdioden für die Oberflächenmontage (DIAC)

Version 2013-12-12



Breakover voltage
Durchbruchspannung

28 ... 45 V

Glass case MiniMELF
Glassgehäuse MiniMELF

DO-213AA

Weight approx. – Gewicht ca.

0.04 g

Standard packaging taped and reeled
Standard Lieferform gegurtet auf Rolle



Please note PCN023 for change of case material and parameters:
Bitte PCN023 beachten wegen Änderung Gehäusematerial und Parameter:
http://diotec.com/tl_files/diotec/files/pdf/products/pcn/pcn023_br100-03lld_br100-04lld.pdf

Maximum ratings

Grenzwerte

Power dissipation Verlustleistung	$T_A = 50^\circ\text{C}$	P_{tot}	150 mW ¹⁾
Peak pulse current (120 Hz pulse repetition rate) Max. Triggerstrom (120 Hz Puls-Wiederholrate)	$t_p \leq 20 \mu\text{s}$	I_{PM}	$\pm 2 \text{ A}^{1)}$
Operating Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_j T_s	-50...+100°C -50...+175°C

Characteristics

Kennwerte

Breakover voltage Durchbruchspannung	$dV/dt = 10 \text{ V}/\mu\text{s}$	BR100-03LLD BR100-04LLD	V_{BO} V_{BO}	28 ... 36 V 35 ... 45 V
Breakover current – Durchbruchstrom	$V = 98\% V_{\text{BO}}$		I_{BO}	$< 50 \mu\text{A}$
Asymmetry of breakover voltage Unsymmetrie der Durchbruchspannung	$ V_{(\text{BO})\text{F}} - V_{(\text{BO})\text{R}} $		ΔV_{BO}	$< 3 \text{ V}$
Foldback voltage – Spannungs-Rücksprung $\Delta I = I_{\text{BO}}$ to/auf $I_{\text{F}} = 10 \text{ mA}$	$dV/dt = 10 \text{ V}/\mu\text{s}$		$\Delta V_{\text{F/R}}$	$> 5 \text{ V}$
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft			R_{thA}	$< 150 \text{ K/W}^{1)}$
Thermal resistance junction to terminal Wärmewiderstand Sperrschicht – Anschluss			R_{thT}	$< 70 \text{ K/W}$

¹ Mounted on P.C. board with 25 mm² copper pads at each terminal
Montage auf Leiterplatte mit 25 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss

